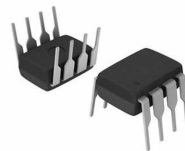


SN75HVD12P-HX 总线收发器电路

SN75HVD12P-HX是一款具有 3.3V/5V 电压供应、半双工通信、具备±15KV ESD保护的 RS485/RS-422 收发器电路。该电路内部包含一路驱动器和一路接收器。

SN75HVD12P-HX具有增强的摆率限制，有助于降低输出电磁干扰（EMI），并减少由不匹配的终端连接引起的反射，实现无误码数据传输速率达到500 kbps。

SN75HVD12P-HX芯片的接收器输入阻抗为 1/8 单位负载，允许最多可挂载 256 个收发器在总线上进行半双工通信。所有驱动器输出均提供±15kV 的人体模式 ESD 保护。此芯片采用 SOP8和PDIP-8封装，并可在-40°C至+125°C的温度范围内工作。



DIP-8

特点

- 3.3V/5V 电源电压
- 静电保护（ESD）：A/B±15KV，符合人体模式（HBM）标准
- 具有 1/8 单位负载，总线允许挂载多达 256 个收发器
- 最高支持 500kbps 的无误码数据传输
- 带有 Fail-safe 功能
- 采用 DIP8封装。

应用

- 工业控制
- 电表
- 工业电机驱动
- 隔离型 RS485 接口
- 自动化暖通空调（HVAC）系统

芯片引脚描述

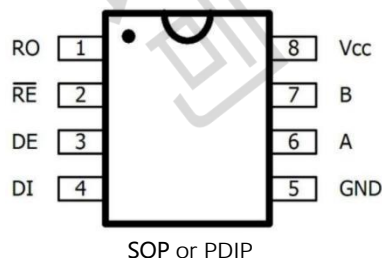
编号	名称	功能	说明
1	RO	接收器 数据输出	当接收器使能时，经过极性判断后，根据以下条件： - 若 $V(A)-V(B) > -50\text{mV}$ ，则 RO 输出高电平。 - 若 $V(A)-V(B) < -200\text{mV}$ ，则 RO 输出低电平。 其中 A 和 B 表示经过极性判断后芯片的同相和反相端。
2	$\overline{\text{RE}}$	接收器 输出使能	当接收器输出使能时，如果 RE 接低电平，RO 输出有效；如果 RE 接高电平，接收器将被关断。同时，当 RE 为高电平，DE 为低电平时，整个芯片处于关断状态。
3	DE	驱动器 输出使能	当 DE 置为高电平时，驱动器输出使能；当 DE 置为低电平时，驱动器关断，驱动器输出为高阻态。同时当 RE 为高电平，DE 为低电平时，整个芯片处于关断状态。
4	DI	驱动器 数据输入	当驱动器输入 DI 为低电平时，强制同相输出为低电平，反相输出为高电平；当 DI 为高电平时，强制同相输出为高电平，反相输出为低电平。
5	GND	地	地
6	A	驱动器数据输出/接收器数据输入	在总线接口中，驱动器的同相输出端连接到接收器的同相输入端。
7	B	驱动器数据输出/接收器数据输入	在总线接口中，驱动器的反相输出端连接到接收器的反相输入端。
8	Vcc	电源	电源

驱动器真值表

输入			输出	
RE	DE	DI	B	A
X	1	1	0	1
X	1	0	1	0
0	0	X	Z	Z
1	0	X	关断	

接收器真值表

输入			输出
RE	DE	A-B	RO
0	X	$\geq -50\text{mV}$	1
0	X	$\leq -200\text{mV}$	0
0	X	开路/短路	1
1	1	X	Z
1	0	X	关断



直流电气参数							
极限参数							
符号	参数名称	最小值	最大值	单位			
VCC	电源电压	3.0	+6.0	V			
DE, RE	控制输入电压	-0.3	+6.0	V			
DI	驱动输入电压	-0.3	+6.0	V			
A,B	驱动输出电压/接收输入	-8.0	+13.0	V			
TSTG	存储温度范围	-65	+150	°C			
TOP	工作温度范围	-40	+125	°C			
P _D	SOP-8 (+70°C以上)		471	mW			
T _L	焊锡温度 (10 秒)		+300	°C			
直流特性 (V _{CC} =+3.3V±5%, TA=25°C)							
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
驱动器							
差分驱动输出(无负载)	VOD1	图 1	2			V	
差分驱动输出	VOD2	R=50Ω(RS-422) 图 1	1.2			V	
		R=27Ω(RS-485) 图 1	1.2			V	
差分输出幅值变化 ¹	ΔVOD	R=50Ω or R=27Ω 图 1			0.2	V	
驱动器输出共模电平	VOC	R=50Ω or R=27Ω 图 1	0		3	V	
驱动器输出共模电平变化	ΔVOC	R=50Ω or R=27Ω 图 1			0.2	V	
输入高电平	V _{IH1}	DE,DI, RE	2.0			V	
输入低电平	V _{IL1}	DE,DI, RE			0.8	V	
输入迟滞	V _{HYS}	DE,DI, RE		100		mV	
输入电流	I _{IN1}	DE,DI, RE ²			±2	uA	
输入电流(A 与 B)	I _{IN4}	DE=GND, VIN=12V			125	uA	
		VCC=GNDor5.25V, VIN=-7V	-75				
驱动器输出短路电流	IOD1	-7V≤V _{OUT} ≤VCC	-100			mA	
		0V≤V _{OUT} ≤12V			100	mA	
		0V≤V _{OUT} ≤VCC	±25			mA	
接收器							
接收器差分输入阈值电压	V _{TH}	-7V≤V _{CM} ≤+12V	-200		-50	mV	
接收器差分输入阈值电压迟滞	ΔV _{TH}			40		mV	
接收器输出高电平	V _{OH}	I _O =-4mA,V _{ID} =1V	V _{CC} -0.4			V	
接收器输出低电平	V _{OL}	I _O =4mA,V _{ID} =-1V	0		0.4	V	
接收器输出高阻态漏电流	I _{OZR}	0.4V≤V _O ≤2.4V			±1	uA	
接收器输入阻抗	R _{IN}	-7V≤V _{CM} ≤+12V	96			KΩ	
接收器输出短路电流	I _{OSR}	0V≤V _{RO} ≤VCC	+7		+95	mA	
供电电流							
静态供电电流	I _{CC}	No load, RE=DI=GNDorV _{CC}	DE=VCC	450	600	uA	
			DE=GND	450	600	uA	
关断电流	I _{SHDN}	DE=GND, RE=V _{CC}	0.1		10	uA	
静电保护特性							
静电保护 (A 管脚,B 管脚)		接触放电模型	±12			KV	
		人体模型	±15			KV	
		人体模型	+4			KV	
交流特性 (V _{CC} =3.3V±5%, TA=25°C)							
参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位	
驱动器输入输出延时	t _{DPLH}	R _{DIFF} =54Ω, CL=54pF 图 3, 5	25	72	10	ns	
	t _{DPHL}		25	72	10	ns	
驱动器输入输出延时之差	t _{DSKEW}	R _{DIFF} =54Ω CL ₁ =CL ₂ =100pF 图 3,5		-3	±1	ns	
驱动器上升、下降时间	t _{DR} ,t _{DF}	R _{DIFF} =54Ω CL ₁ =CL ₂ =100pF 图 3,5	40	70	12	ns	
最大速率	f _{MAX}			50		kb	
驱动器使能到输出为高电平	t _{DZH}	CL=100pF,S ₂ 关断 图 4,6			25	ns	
驱动器使能到输出为低电平	t _{DZL}	CL=100pF,S ₁ 关断 图 4,6			25	ns	
驱动器从输出低到关断时间	t _{DLZ}	CL=15pF,S ₁ 关断 图 4,6			500	ns	
驱动器从输出高到关断时间	t _{DHZ}	CL=15pF,S ₂ 关断 图 4,6			500	ns	
接收器输入输出延时	t _{RPLH}	V _{ID} ≥2.0V;					
	t _{RPHL}	V _{ID} 上升/下降时间小于 15ns 图 7,9		125	250	ns	
t _{RPLH} -t _{RPHL} 接收器输入输出延时之差	t _{RSKD}	V _{ID} 上升/下降时间小于 15ns 图 7,9		10	±50	ns	
接收器使能到输出低	t _{RZL}	CL=100pF,S ₁ 关断 图 2.8		20	120	ns	
接收器使能到输出高	t _{RZH}	CL=100pF,S ₂ 关断 图 2.8		20	120	ns	
接收器从输出高到关断	t _{RHZ}	CL=100pF,S ₁ 关断 图 2.8		20	120	ns	
接收器从输出低到关断	t _{RLZ}	CL=100pF,S ₂ 关断 图 2.8		20	120	ns	
芯片关断时间	t _{SHDN}	³	50	200	600	ns	
从芯片关断到驱动器使能, 到输出为高电平	t _{DZH} (SH DN)	CL=15pF,S ₂ 关断 图 4.6			4500	ns	
从芯片关断到驱动器使能, 到输出为低电平	Td _{zl} (SH DN)	CL=15pF,S ₁ 关断 图 4.6			4500	ns	
从芯片关断到接收器使能, 到输出为高电平	t _{RZH} (SH DN)	CL=100pF,S ₂ 关断 图 2.8			3500	ns	
从芯片关断到接收器使能, 到输出为低电平	t _{RZL} (SH DN)	CL=100pF,S ₁ 关断 图 2.8			3500	ns	

注: 1 ΔVOD 和 ΔVOC 分别表示 DI 变化时 VOD 和 VOC 的变化量。

2 电流流入器件时为正, 流出器件时为负; 除非特别说明, 所有电压以地为参考点。

3 当 R_{ON}的E_{ON}=1 且 DE=0 时, SN75HVD12P-HX进入关断状态。如果关断状态持续时间小于 50ns, 则芯片不会进入关断状态。

如果关断状态持续时间超过 600ns, 则芯片确保进入关断状态。

功能描述

总线负载

SN75HVD12P-HX芯片支持最多256个收发器挂接在同一总线上。标准RS-485接收器的输入阻抗为12K Ω （1个单位负载），而SN75HVD12P-HX具有1/8单位负载的输入阻抗（96K Ω ），允许最多256个收发器挂接在同一总线上。这些器件可以任意组合，或者与其他RS485收发器组合使用，只要总负载不超过32个单位负载即可挂接在同一总线。

低功耗关断模式

当 RE 为高电平, DE 为低电平时, 芯片进入低功耗关断模式。关断电流典型值为 1.8uA。RE 和 DE 可以同时驱动, 如果 RE 为高电平, DE 为低电平保持时间小于 50ns, 芯片不会进入关断模式; 如果保持时间超过 600ns, 芯片会确保进入关断模式。

降低 EMI 和反射

SN75HVD12P-HX的限速率驱动器可以降低电磁干扰（EMI），并降低由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射，实现最高 500kbps 的无误码数据传输。

驱动器输出保护

SN75HVD12P-HX具有过大电流和功耗过大保护机制。一种是过流保护电路，当总线异常导致芯片电流过大时，芯片内部的过流保护电路起作用，来保证驱动电流不会超过设定值。另一种是过温保护，当芯片功耗太大，温度上升时，过温保护电路保证芯片不会损坏。如果芯片进入过温保护状态，驱动器输出为高阻态。

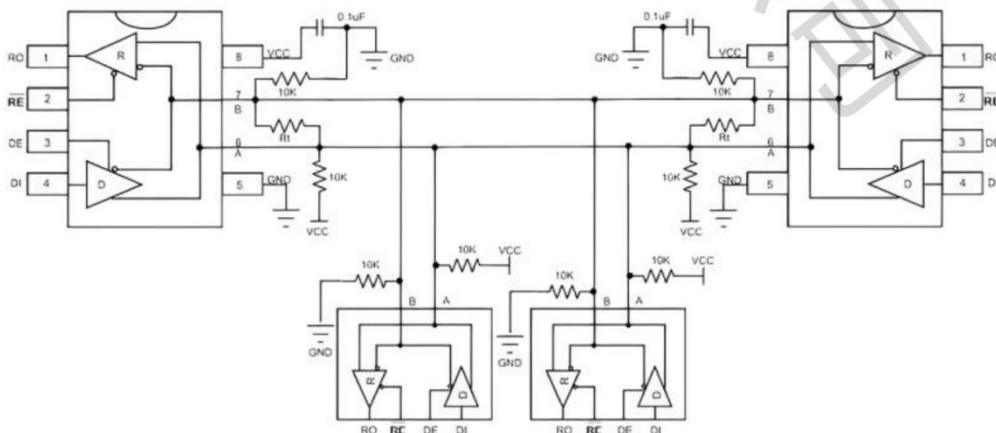
典型应用

SN75HVD12P-HX常用于双向数据通信的多点网络。为了降低反射,应当在传输线的两端以其特性阻抗进行 终端匹配,主干线以外的分支线路的长度应尽可能短。

静电保护

SN75HVD12P-HX的所有管脚都具有静电泄放保护电路,以防止人手触摸或者装配时的静电放电事件对芯片造成损坏。驱动器的输出和接收器的输入管脚采用 R_t 为特征匹配阻抗,典型值为 120Ω 增强的ESD保护电路,可以抵抗 $\pm 15kV$ 的人体模式ESD冲击而不会损坏。所有ESD保护电路在正常工作时处于关断状态,不消耗电流。在ESD事件后,H以 I_{H1} 保证正常工作,而不会出现门锁或损坏情况。SN75HVD12P-HX ESD保护性能测试方法包括 $\pm 15kV$ 人体模型和 $\pm 12kV$ IEC61000-4-2 接触放电。

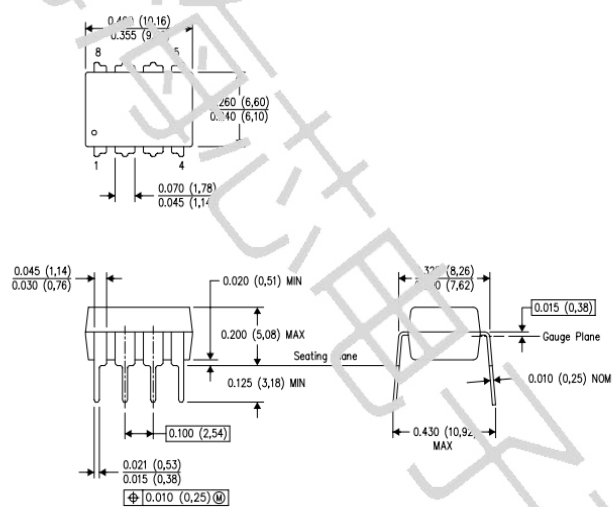
典型应用图



R_t 为特征匹配阻抗，典型值为120Ω

封装包装

DIP8 (Package Outline Dimensions)



NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.